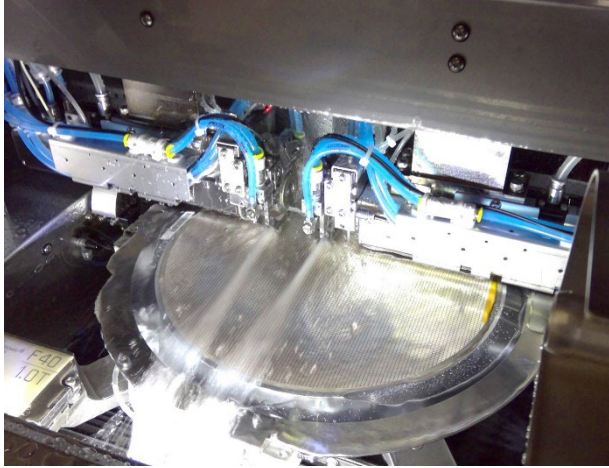
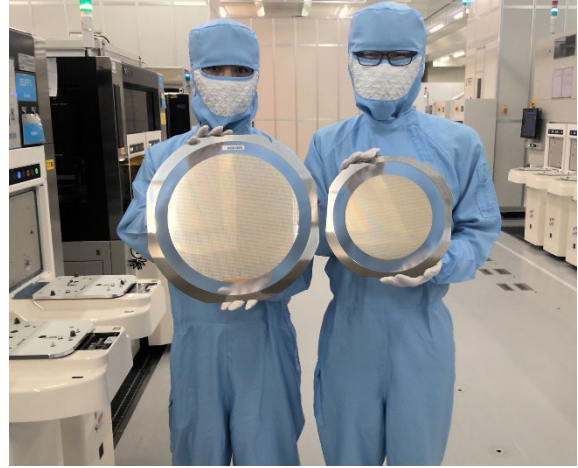


NEWS RELEASE

12 インチ Si ウェハを用いたパワー半導体チップをモジュール組立工程に供給開始
需要が旺盛な Si パワー半導体チップの安定供給で GX に貢献



12 インチ Si ウェハのダイシング工程
(ウェハを切断してチップ化する工程)



12 インチ Si ウェハ対応生産ラインと製造したウェハ
(左の作業者が持つ Si ウェハが製造した 12 インチ Si ウェハ、右は同工場で製造した 8 インチ Si ウェハ)

三菱電機株式会社は、パワーデバイス製作所 福山工場で製造する 12 インチ Si ウェハを用いたパワー半導体チップのモジュール組立工程に向けた本格的な供給を 9 月 30 日に開始しました。これにより、民生分野向けを皮切りに、最新の Si パワー半導体モジュールの安定生産が可能になります。当社は、今後の高まる需要に対して、迅速かつ安定的に製品を供給することで、各分野のパワーエレクトロニクス機器の省エネ化を実現し、GX (Green Transformation) に貢献していきます。

近年、脱炭素社会の実現に貢献するキーデバイスとして、電力を効率よく変換するパワー半導体の需要が拡大・多様化する中、現在のパワー半導体市場で主力製品である Si パワー半導体は、電気自動車、民生機器、産業用機器、再生可能エネルギー、電鉄などさまざまな分野で活用され、引き続き市場拡大が予測されています。

パワーデバイス製作所 福山工場は、Si ウェハを用いたパワー半導体の製造におけるウェハプロセス工程を担当する工場です。当社が中期計画で掲げる「2025 年度までに、Si パワー半導体のウェハプロセス工程における生産能力を、2020 年度比で約 2 倍に拡大する計画」の一翼を担っています。今回、12 インチ Si ウェハを用いたパワー半導体チップをモジュール組立工程に向けて本格的に供給を開始したことで、最新の Si パワー半導体モジュールの安定生産が可能となり、今後の高まるパワー半導体の需要に対して、迅速かつ安定的に製品を供給することで、各分野のパワーエレクトロニクス機器の省エネ化を実現し、GX に貢献していきます。

パワーデバイス製作所 福山工場の概要

所在地	広島県福山市大門町旭 1 番地 4
建屋面積・構造	延床面積 約 46,500m ² 、3 階建て
生産品目	Si パワー半導体(8 インチ Si ウェハ、12 インチ Si ウェハ)
担当生産工程	ウェハプロセス工程(前工程)
沿革	<ul style="list-style-type: none"> ・2021 年 11 月 稼働開始 ・2022 年 4 月 8 インチ Si ウェハ対応生産ラインの量産稼働を開始 ・2023 年 8 月 12 インチ Si ウェハ対応生産ラインの設置完了 ・2024 年 9 月 12 インチ Si ウェハを用いたパワー半導体チップのモジュール組立工程に向けた本格的な供給を開始

お問い合わせ先

<報道関係からのお問い合わせ先>

三菱電機株式会社 広報部

〒100-8310 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号

TEL 03-3218-2332 FAX 03-3218-2431

<お客様からのお問い合わせ先>

三菱電機株式会社 半導体・デバイス第一事業部 パワーデバイス営業部

〒100-8310 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号

<https://www.MitsubishiElectric.co.jp/semiconductors/powerdevices/contact/>

ウェブサイト

パワー半導体デバイスウェブサイト

<https://www.MitsubishiElectric.co.jp/semiconductors/powerdevices/>